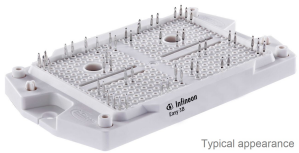
EasyPACK™ Modul with TRENCHSTOP™ IGBT7 and CoolSiC™ Schottky diode und PressFIT / NTC

Eigenschaften


Typical appearance

- Elektrische Eigenschaften
  - V_{CES} = 950 V
  - $I_{C\ nom}$ = 200 A / I_{CRM} = 300 A
  - CoolSiC™ Schottky Diode Gen 5
  - Niedrige Schaltverluste
  - Trenchstop™ IGBT7
- Mechanische Eigenschaften
  - Integrierter NTC Temperatur Sensor
  - Al_2O_3 Substrat mit kleinem thermischen Widerstand
  - PressFIT Verbindungstechnik
  - Kompaktes Design

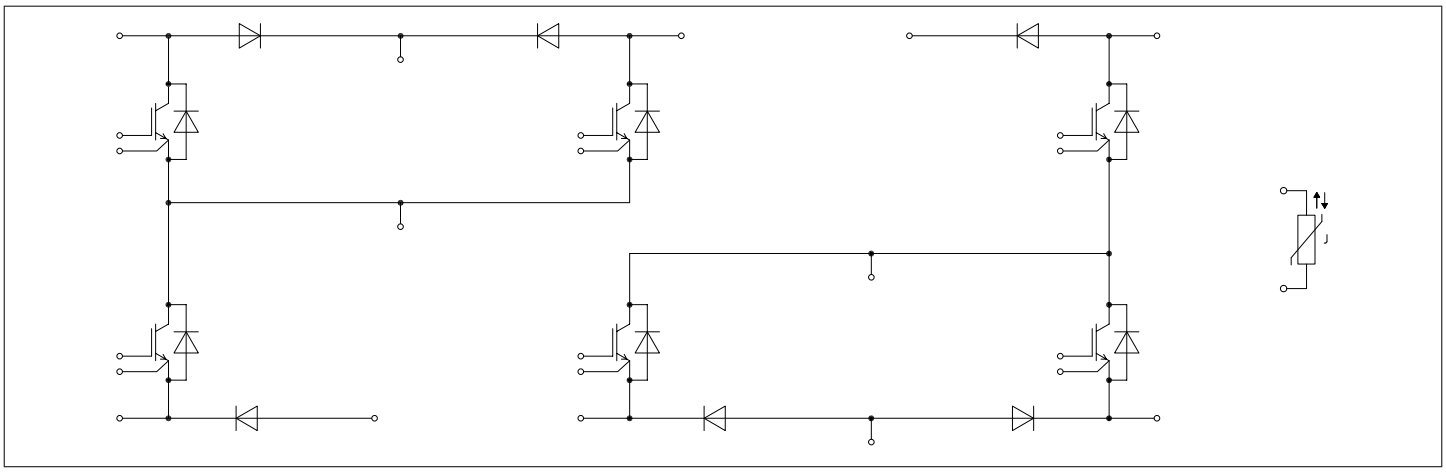
Potenzielle Anwendungen

- 3-Level-Applikationen
- Solar Anwendungen
- USV-Systeme

Produktvalidierung

- Qualifiziert für Industrieanwendungen entsprechend den relevanten Tests der IEC 60747, 60749 und 60068

Beschreibung



Inhalt

	Beschreibung	1
	Eigenschaften	1
	Potenzielle Anwendungen	1
	Produktvalidierung	1
	Inhalt	2
1	**Gehäuse**	3
2	**IGBT, Hochsetzsteller**	3
3	**Diode, Revers**	5
4	**Diode, Hochsetzsteller**	5
5	**NTC-Widerstand**	6
6	**Kennlinien**	7
7	**Schaltplan**	12
8	**Gehäuseabmessungen**	12
9	**Modul-Label-Code**	13
	Änderungshistorie	14
	Disclaimer	15

1 Gehäuse

Tabelle 1 Isolationskoordination

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Isolations-Prüfspannung	V_{ISOL}	RMS, f = 50 Hz, *t* = 1 min	3.2	kV
Innere Isolation		Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140)	Al_2O_3	
Kriechstrecke	d_{Creep}	Kontakt - Kühlkörper	11.2	mm
Kriechstrecke	d_{Creep}	Kontakt - Kontakt	6.8	mm
Luftstrecke	d_{Clear}	Kontakt - Kühlkörper	9.4	mm
Luftstrecke	d_{Clear}	Kontakt - Kontakt	5.5	mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	*CTI*		> 400	
Relativer Temperaturindex (elektr.)	*RTI*	Gehäuse	140	°C

Tabelle 2 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min.	Typ.	Max.	
Modulstreuinduktivität	L_{sCE}				18		nH
Lagertemperatur	T_{stg}			-40		125	°C
Anzugsdrehmoment f. Modulmontage	*M*	- Montage gem. gültiger Applikationsschrift	M5, Schraube	1.3		1.5	Nm
Gewicht	*G*				78		g

Anmerkung: The current under continuous operation is limited to 25A rms per connector pin.

2 IGBT, Hochsetzsteller

Tabelle 3 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Kollektor-Emitter-Sperrspannung	V_{CES}		T_{vj} = 25 °C	950	V
Implementierter Kollektor-Strom	I_{CN}			200	A
Kollektor-Dauergleichstrom	I_{CDC}	$T_{vj\,max}$ = 175 °C	T_H = 65 °C	120	A
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom	I_{CRM}	t_p begrenzt durch $T_{vj\,op}$		300	A
Gate-Emitter-Spitzenspannung	V_{GES}			±20	V

Tabelle 4 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min.	Typ.	Max.	
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung	$V_{CE\,sat}$	I_C = 45 A, V_{GE} = 15 V	T_{vj} = 25 °C		1.23	1.48	V
			T_{vj} = 125 °C		1.27		
			T_{vj} = 150 °C		1.27		
Gate-Schwellenspannung	V_{GEth}	I_C = 3.25 mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25 °C		4.35	5.10	5.85	V
Gateladung	Q_G	V_{GE} = ±15 V, V_{CC} = 600 V			0.45		µC
Interner Gatewiderstand	R_{Gint}	T_{vj} = 25 °C			1.5		Ω
Eingangskapazität	C_{ies}	f = 100 kHz, T_{vj} = 25 °C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V			12.6		nF
Rückwirkungskapazität	C_{res}	f = 100 kHz, T_{vj} = 25 °C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V			0.039		nF
Kollektor-Emitter-Reststrom	I_{CES}	V_{CE} = 950 V, V_{GE} = 0 V	T_{vj} = 25 °C			0.026	mA
Gate-Emitter-Reststrom	I_{GES}	V_{CE} = 0 V, V_{GE} = 20 V, T_{vj} = 25 °C				100	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{don}	I_C = 45 A, V_{CC} = 500 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 3.9 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.068		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.078		
			T_{vj} = 150 °C		0.080		
Anstiegszeit (induktive Last)	t_r	I_C = 45 A, V_{CC} = 500 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 3.9 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.007		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.008		
			T_{vj} = 150 °C		0.009		
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{doff}	I_C = 45 A, V_{CC} = 500 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 1.5 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.198		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.263		
			T_{vj} = 150 °C		0.280		
Fallzeit (induktive Last)	t_f	I_C = 45 A, V_{CC} = 500 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 1.5 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.043		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.089		
			T_{vj} = 150 °C		0.097		
Einschaltverlustenergie pro Puls	E_{on}	I_C = 45 A, V_{CC} = 500 V, L_σ = 35 nH, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 3.9 Ω, di/dt = 4000 A/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		0.473		mJ
			T_{vj} = 125 °C		0.544		
			T_{vj} = 150 °C		0.557		
Abschaltverlustenergie pro Puls	E_{off}	I_C = 45 A, V_{CC} = 500 V, L_σ = 35 nH, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 1.5 Ω, dv/dt = 3200 V/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		1.14		mJ
			T_{vj} = 125 °C		1.95		
			T_{vj} = 150 °C		2.19		
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro IGBT, λ_{grease} = 3.3 W/(m·K)			0.433		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\,op}$			-40		150	°C

3 Diode, Revers

Tabelle 5 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}		T_{vj} = 25 °C	1200	V
Dauergleichstrom	I_F			75	A
Periodischer Spitzenstrom	I_{FRM}	t_P = 1 ms		150	A
Grenzlastintegral	I^2t	t_P = 10 ms, V_R = 0 V	T_{vj} = 125 °C	453	A^2s
			T_{vj} = 175 °C	392	

Tabelle 6 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min.	Typ.	Max.	
Durchlassspannung	V_F	I_F = 75 A, V_{GE} = 0 V	T_{vj} = 25 °C		1.72	2.10	V
			T_{vj} = 125 °C		1.59		
			T_{vj} = 175 °C		1.52		
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro Diode, λ_{grease} = 3.3 W/(m·K)			0.933		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\,op}$			-40		175	°C

Anmerkung: $T_{vj\,op}$ > 150°C ist im Überlastbetrieb zulässig. Detaillierte Angaben sind AN 2018-14 zu entnehmen.

4 Diode, Hochsetzsteller

Tabelle 7 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}		T_{vj} = 25 °C	1200	V
Dauergleichstrom	I_F			60	A
Periodischer Spitzenstrom	I_{FRM}	t_P = 1 ms		120	A
Grenzlastintegral	I^2t	t_P = 10 ms, V_R = 0 V	T_{vj} = 125 °C	472	A^2s
			T_{vj} = 150 °C	450	

Tabelle 8 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min.	Typ.	Max.	
Durchlassspannung	V_F	I_F = 45 A, V_{GE} = 0 V	T_{vj} = 25 °C		1.38	1.58	V
			T_{vj} = 125 °C		1.52		
			T_{vj} = 150 °C		1.60		
Rückstromspitze	I_{RM}	V_{CC} = 500 V, I_F = 45 A, V_{GE}=-15 V, -di$_F$/dt = 4000 A/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		46.2		A
			T_{vj} = 125 °C		46.2		
			T_{vj} = 150 °C		46.2		
Sperrverzögerungsladung	Q_r	V_{CC} = 500 V, I_F = 45 A, V_{GE}=-15 V, -di$_F$/dt = 4000 A/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		1.27		µC
			T_{vj} = 125 °C		1.27		
			T_{vj} = 150 °C		1.27		
Abschaltenergie pro Puls	E_{rec}	V_{CC} = 500 V, I_F = 45 A, V_{GE}=-15 V, -di$_F$/dt = 4000 A/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		0.128		mJ
			T_{vj} = 125 °C		0.128		
			T_{vj} = 150 °C		0.128		
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro Diode, λ_{grease} = 3.3 W/(m·K)			0.689		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\,op}$			-40		150	°C

5 NTC-Widerstand

Tabelle 9 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Nennwiderstand	R_{25}	T_{NTC} = 25 °C		5		kΩ
Abweichung von R_{100}	$\Delta R/R$	T_{NTC} = 100 °C, R_{100} = 493 Ω	-5		5	%
Verlustleistung	P_{25}	T_{NTC} = 25 °C			20	mW
B-Wert	$B_{25/50}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/50}(1/T_2-1/(298{,}15\ K))]$		3375		K
B-Wert	$B_{25/80}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/80}(1/T_2-1/(298{,}15\ K))]$		3411		K
B-Wert	$B_{25/100}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/100}(1/T_2-1/(298{,}15\ K))]$		3433		K

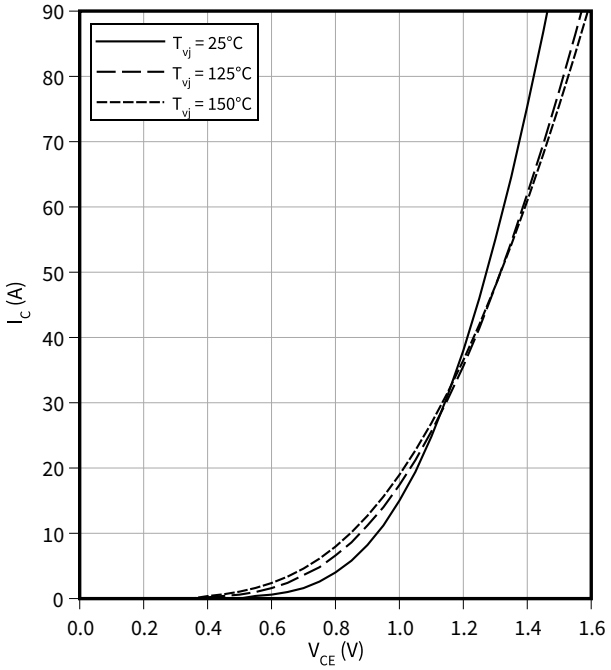
Anmerkung: Angaben gemäß gültiger Application Note.

6 Kennlinien

Output characteristic (typical), IGBT, Hochsetzsteller

$I_C = f(V_{CE})$

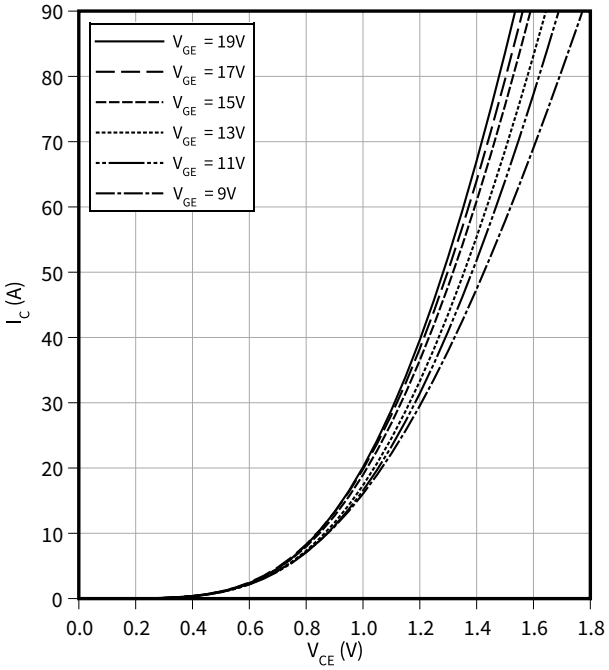
V_{GE} = 15 V



Ausgangskennlinienfeld (typisch), IGBT, Hochsetzsteller

$I_C = f(V_{CE})$

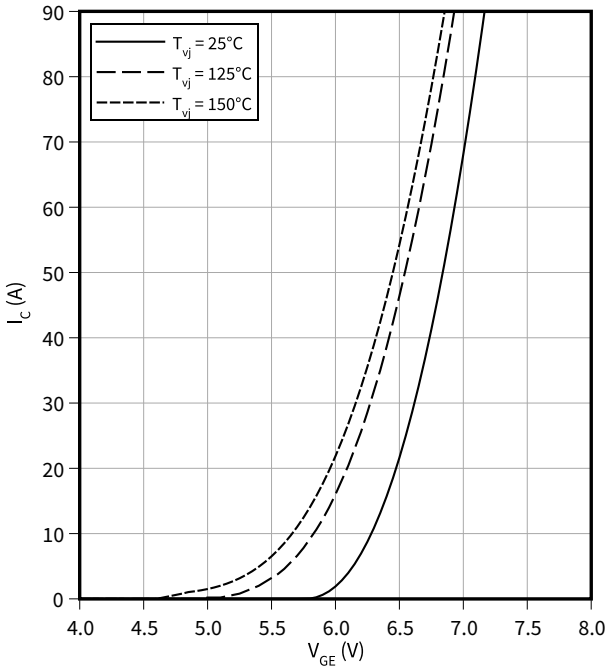
T_{vj} = 150 °C



Übertragungscharakteristik (typisch), IGBT, Hochsetzsteller

$I_C = f(V_{GE})$

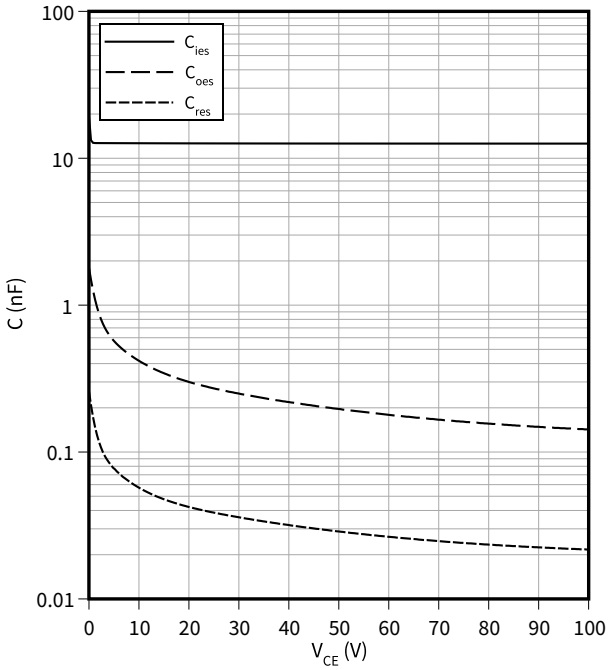
V_{CE} = 20 V



Kapazitäts Charakteristik (typisch), IGBT, Hochsetzsteller

$C = f(V_{CE})$

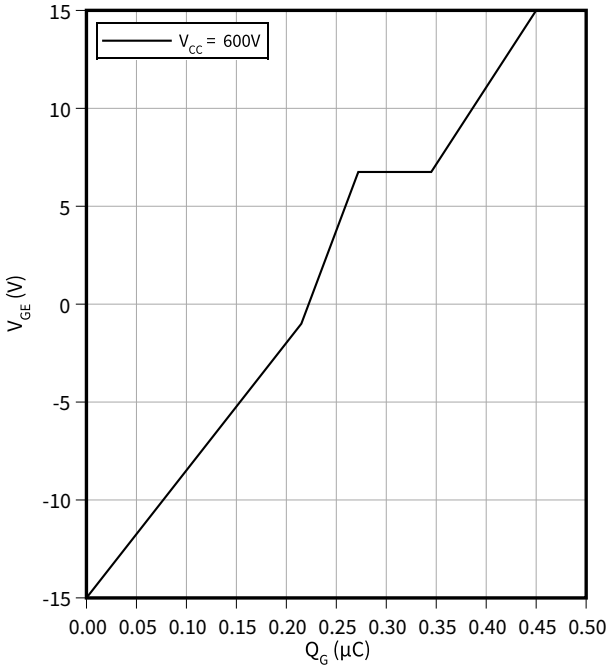
f = 100 kHz, V_{GE} = 0 V, T_{vj} = 25 °C



Gateladungs Charakteristik (typisch), IGBT, Hochsetzsteller

$V_{GE} = f(Q_G)$

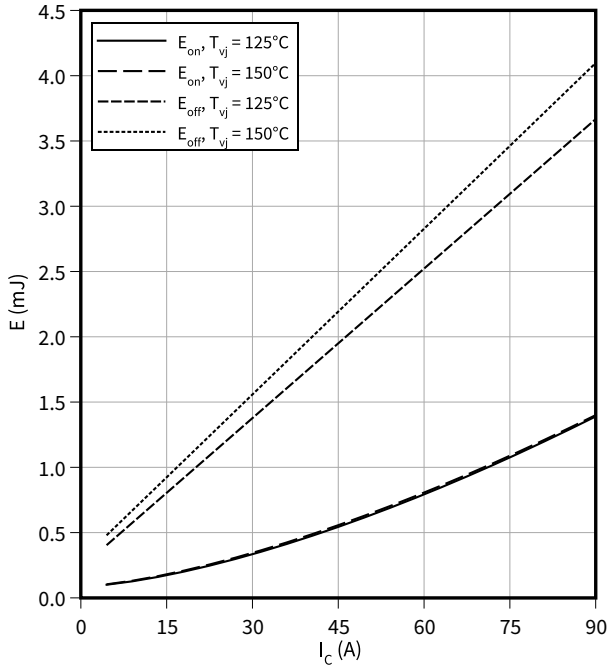
$I_C = 200\ A$, $T_{vj} = 25\ °C$



Switching losses (typical), IGBT, Hochsetzsteller

$E = f(I_C)$

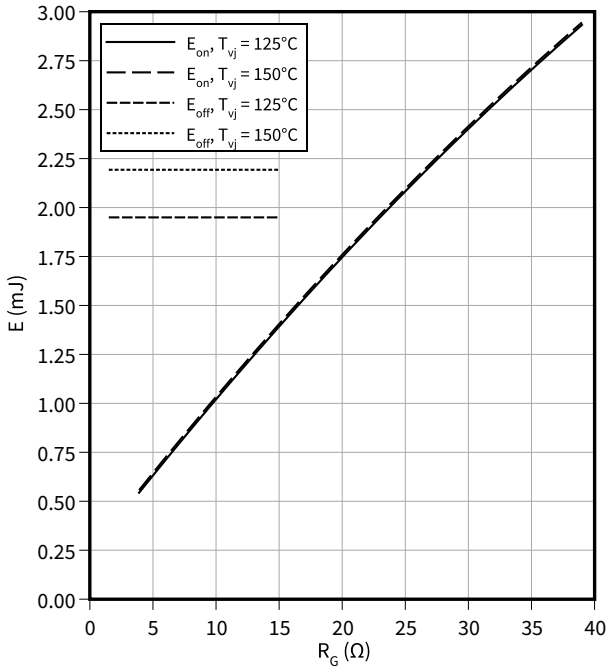
$R_{Goff} = 1.5\ \Omega$, $R_{Gon} = 3.9\ \Omega$, $V_{CC} = 500\ V$, $V_{GE} = \pm 15\ V$



Switching losses (typical), IGBT, Hochsetzsteller

$E = f(R_G)$

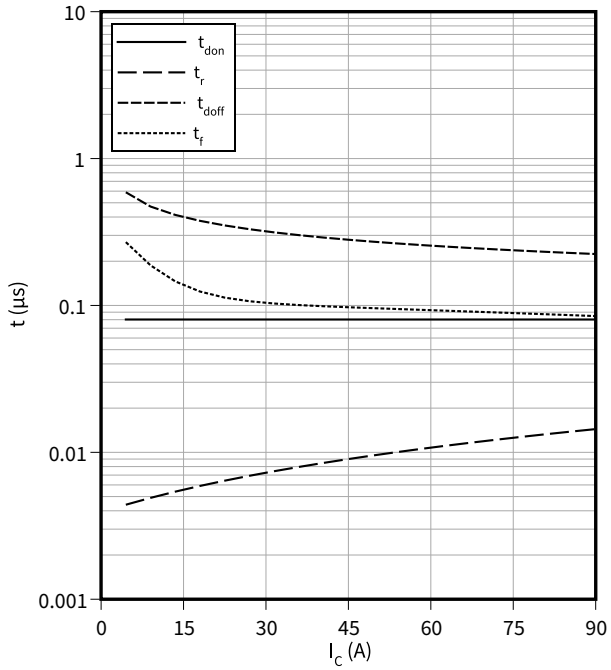
$I_C = 45\ A$, $V_{CC} = 500\ V$, $V_{GE} = \pm 15\ V$



Switching times (typical), IGBT, Hochsetzsteller

$t = f(I_C)$

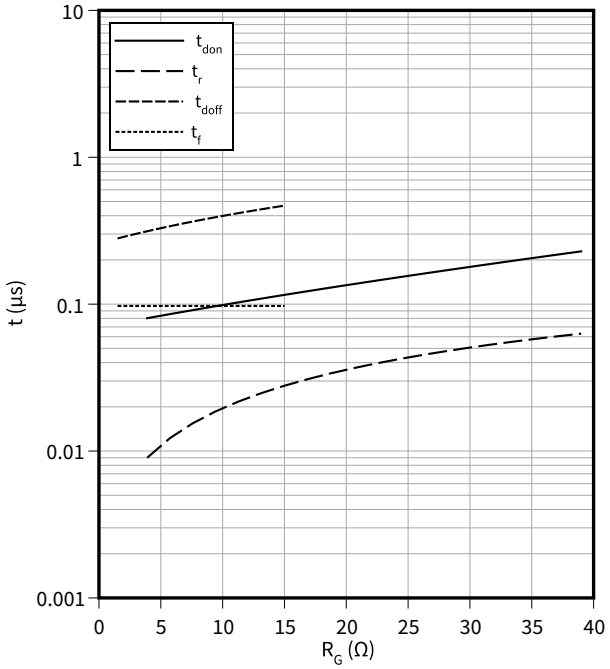
$R_{Goff} = 1.5\ \Omega$, $R_{Gon} = 3.9\ \Omega$, $V_{CC} = 500\ V$, $V_{GE} = \pm 15\ V$, $T_{vj} = 150\ °C$



Switching times (typical), IGBT, Hochsetzsteller

$t = f(R_G)$

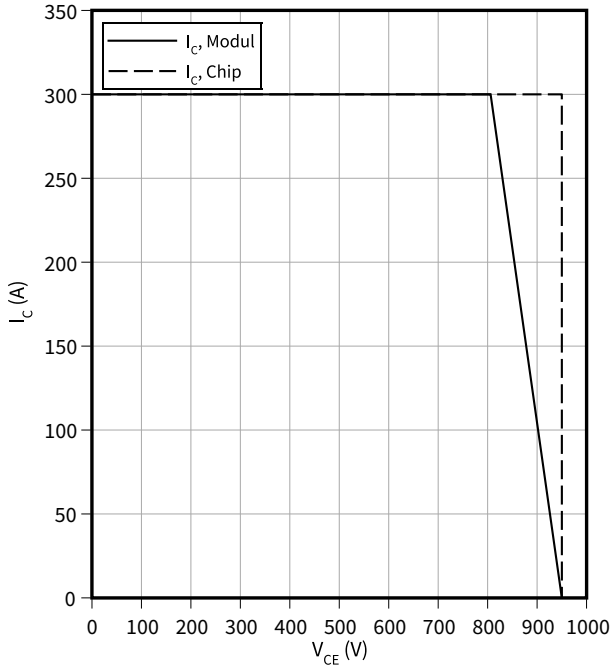
$I_C = 45\ A$, $V_{CC} = 500\ V$, $V_{GE} = \pm 15\ V$, $T_{vj} = 150\ °C$



Reverse bias safe operating area (RBSOA), IGBT, Hochsetzsteller

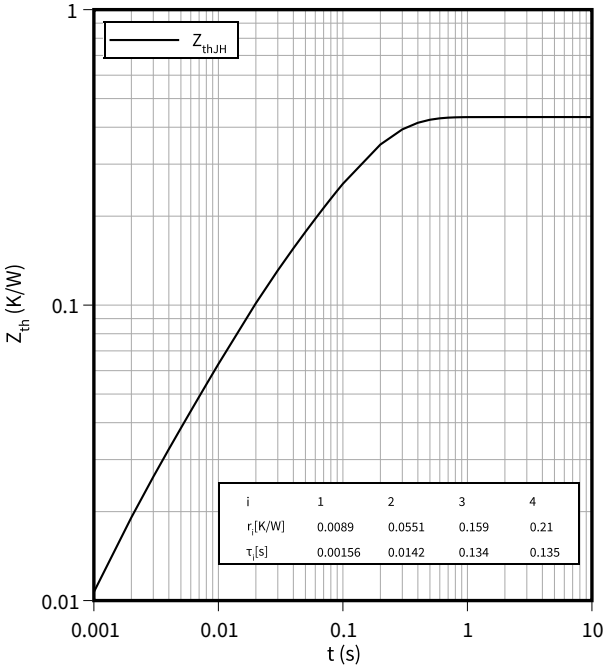
$I_C = f(V_{CE})$

$R_{Goff} = 1.5\ \Omega$, $V_{GE} = \pm 15\ V$, $T_{vj} = 150\ °C$



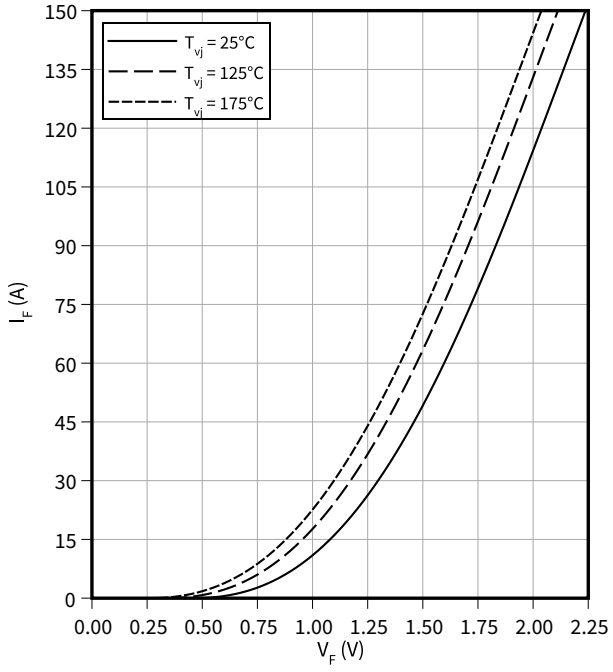
Transient thermal impedance , IGBT, Hochsetzsteller

$Z_{th} = f(t)$



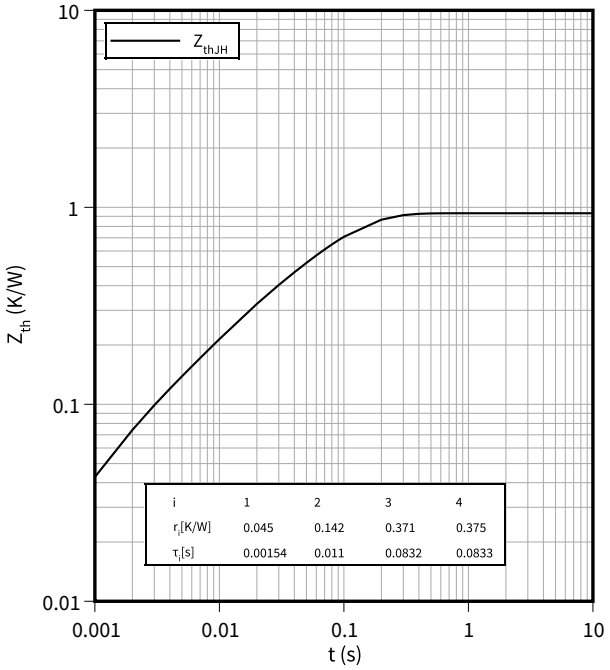
Durchlasskennlinie (typisch), Diode, Revers

$I_F = f(V_F)$



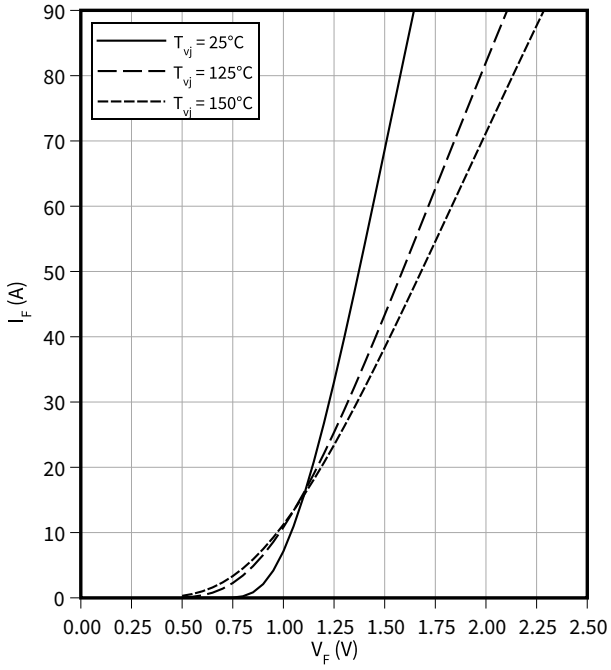
Transienter Wärmewiderstand, Diode, Revers

$Z_{th} = f(t)$



Durchlasskennlinie (typisch), Diode, Hochsetzsteller

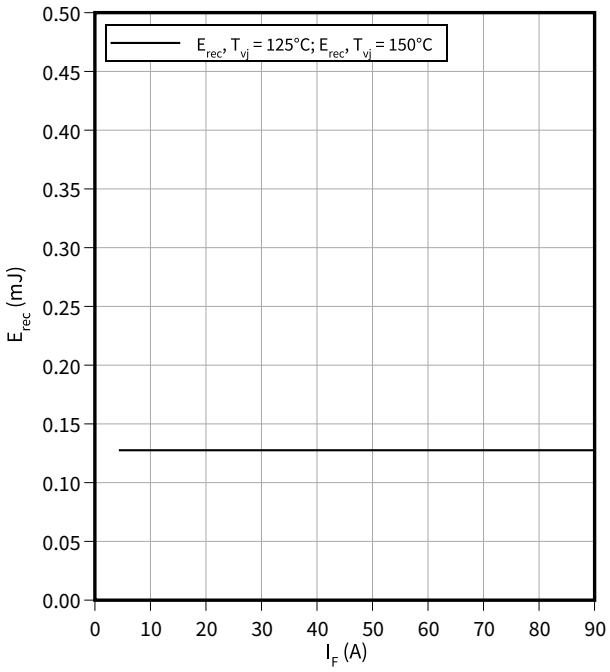
$I_F = f(V_F)$



Schaltverluste (typisch), Diode, Hochsetzsteller

$E_{rec} = f(I_F)$

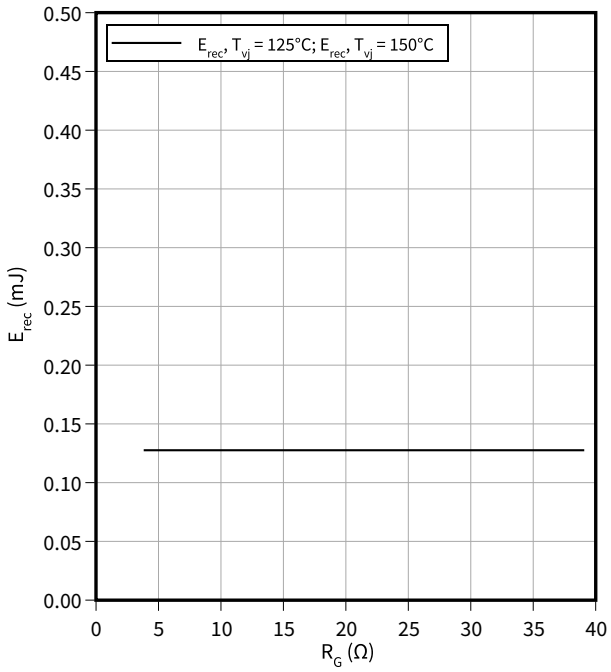
$R_{Gon} = 3.9\ \Omega$, $V_{CC} = 500\ V$



Schaltverluste (typisch), Diode, Hochsetzsteller

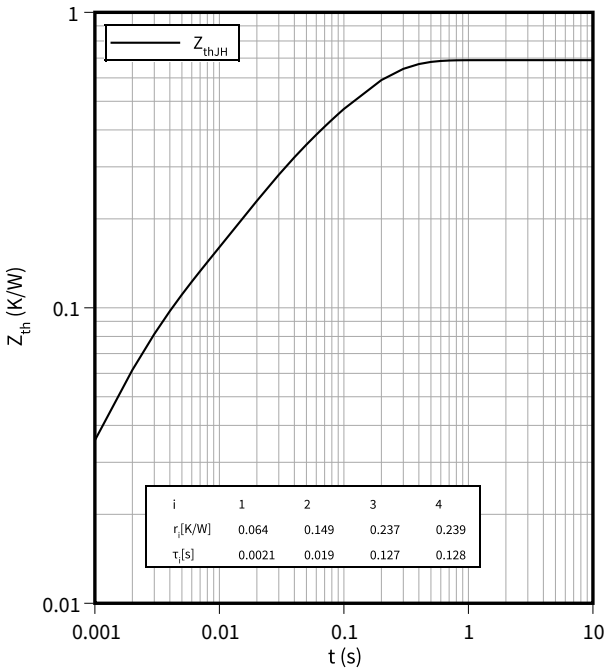
$E_{rec} = f(R_G)$

$I_F = 45\ A$, $V_{CC} = 500\ V$



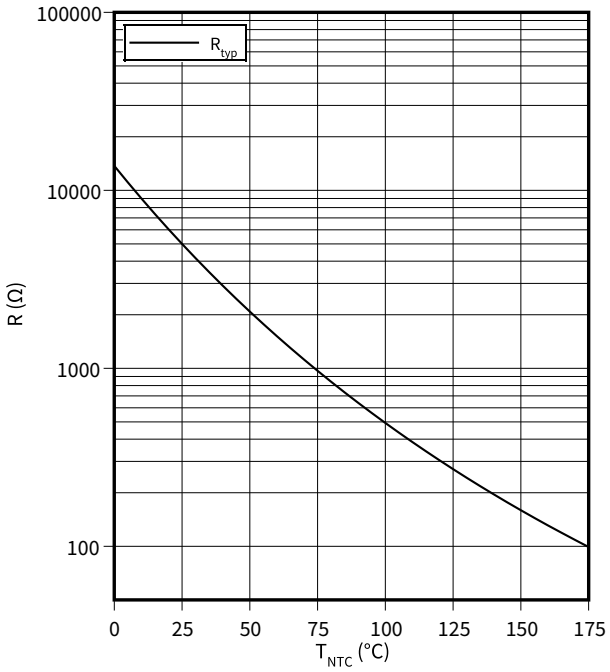
Transienter Wärmewiderstand, Diode, Hochsetzsteller

$Z_{th} = f(t)$



Temperaturkennlinie (typisch), NTC-Widerstand

$R = f(T_{NTC})$



7 Schaltplan

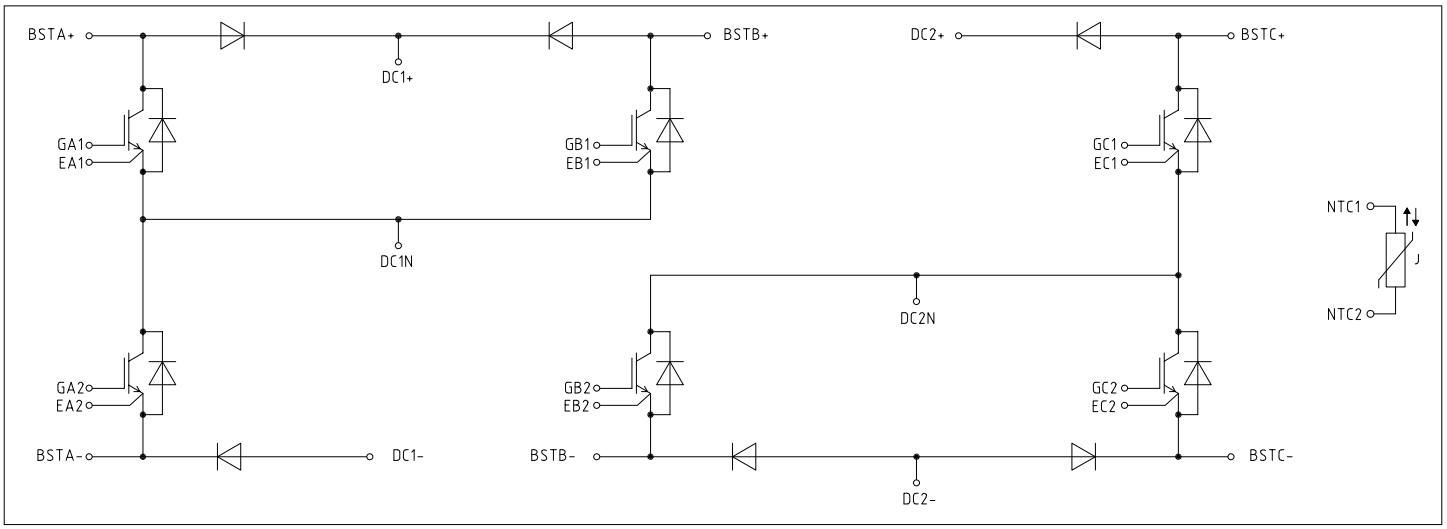


Abbildung 1

8 Gehäuseabmessungen

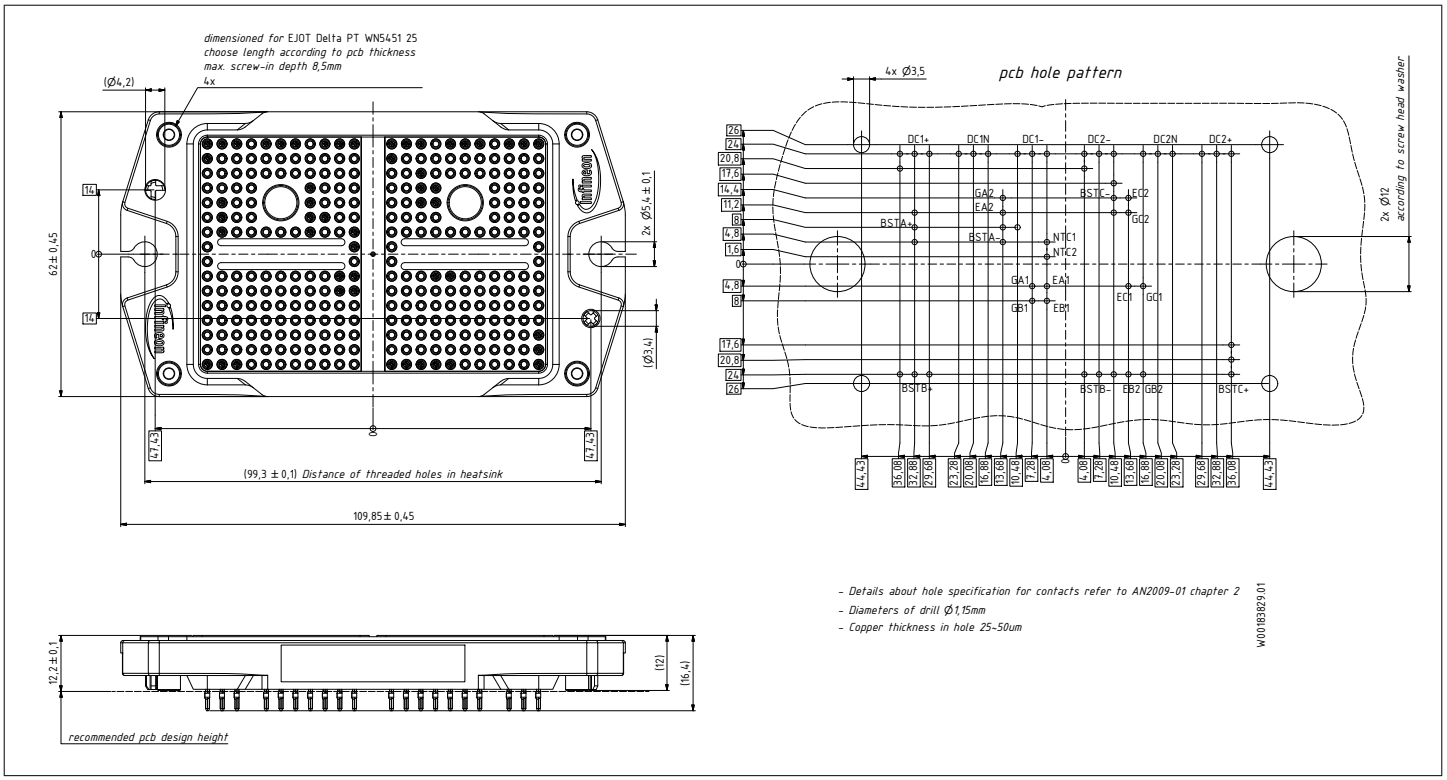


Abbildung 2

9 Modul-Label-Code

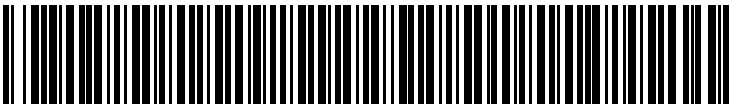
Module label code			
Code format	Data Matrix		Barcode Code128
Encoding	ASCII text		Code Set A
Symbol size	16x16		23 digits
Standard	IEC24720 and IEC16022		IEC8859-1
Code content	*Content* Module serial number Module material number Production order number Date code (production year) Date code (production week)	*Digit* 1 – 5 6 - 11 12 - 19 20 – 21 22 – 23	*Example* 71549 142846 55054991 15 30
Example	 7154914284655054991530		 7154914284655054991530

Abbildung 3

Änderungshistorie

Dokumentenrevision	Freigabedatum	Beschreibung der Änderungen
0.10	2022-04-29	Initial version
1.00	2022-08-24	Final datasheet

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2022-08-24

Published by

Infineon Technologies AG

81726 Munich, Germany

© 2022 Infineon Technologies AG

All Rights Reserved.

Do you have a question about any aspect of this document?

Email: erratum@infineon.com

Document reference
IFX-ABD624-002

Wichtiger Hinweis

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keinesfalls Garantien für die Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes ("Beschaffenheitsgarantie") dar.

Für Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben, die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen, ist jegliche Gewährleistung und Haftung von Infineon Technologies ausgeschlossen, einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, die Gewähr dafür, dass kein geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.

Des Weiteren stehen sämtliche, in diesem Dokument enthaltenen Informationen, unter dem Vorbehalt der Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des Infineon Produktes in den Anwendungen des Kunden anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und Standards durch den Kunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für die beabsichtigte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Produktdaten für diese Anwendung obliegt den technischen Fachabteilungen des Kunden.

Warnhinweis

Aufgrund der technischen Anforderungen können Produkte gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Fragen zu den in diesem Produkt enthaltenen Substanzen, setzen Sie sich bitte mit dem nächsten Vertriebsbüro von Infineon Technologies in Verbindung.

Sofern Infineon Technologies nicht ausdrücklich in einem schriftlichen, von vertretungsberechtigten Infineon Mitarbeitern unterzeichneten Dokument zugestimmt hat, dürfen Produkte von Infineon Technologies nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in welchen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass ein Fehler des Produktes oder die Folgen der Nutzung des Produktes zu Personenverletzungen führen.